

The Data Book Project

DatasheetArchive.com has launched an ambitious effort to digitize thousands of obsolete data books and technical manuals, making them searchable via the DatasheetArchive website.

Scroll down to see the scanned document.

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外 形	備 考		
				V _{CEO} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CBO} 最大値		直 流 又 は バ ル ス h _{FE}		バ イ ア ス		h _{FE} h _{FS} *	h _{ie} h _{is} *	h _{re} h _{rs} *	h _{oe} h _{os} *	f _β f _T *			C _{ob} (pF)	r _{bb} h _{ie} (real)* (Ω)
									(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)									
2SC1380A	東 芝	RF. LN	Si.E	55	5	100	200	150	0.1	18	200 ~700	6	2	6	-1				80*	6		49C	
* # 1409A	日 立	PA	Si.TMe	200	6	2 A	12.5W (T _c =25°C)	150	1	30	100	10	50	10	-50				20*	95	20	267	
* # 1410A	"	"	"	200	6	2 A	12.5W (T _c =25°C)	150	1	30	100	10	50	10	-50				20*	95	20	268	
* # 1413A	"	SW	Si.T	1500	6	5 A	50W (T _c =25°C)	150	I _{CEX} 1 mA	1500				15	-200	t _f < 2.3 μS			4*	175		102	水平偏向用
* # 1416A	東 芝	RF	Si.EP	55	5	50	200	150	0.1	30	350	6	2	6	-1	NF=1dB (f=100Hz, V _{CE} =6V, I _B =-0.1mA)			100*	3	45	195	
* # 1478A	松 下	RF. LN	"	55	5	50	150	175	0.1	10	540	5	2	5	-2	5500	0.4	25	150*	2.2	70	243	
* # 1517A	日 立	PA. SW	Si.E	80	4	1 A	10W (T _c =25°C)	150	5	50	60-200	4	50	4	-50	t _{on} =0.25 μS, t _{off} =3.5 μS t _{tr} =3 μS			150*	30		234	
* 2SC1103A	日 電	PA	Si.T	250	7	100	800	150	0.1	150	80	10	10	30	-10				80*	<4.8	30	84B	
* # 1116A	サンケン	"	Si.TMe	200	6	10A	100W (T _c =25°C)	150	1mA	200	60	4	3 A	12	-500				10*	165	13*	102	2SA747A とコンパリ
* # 1170B	東 芝	"	Si.TMe	1500	5	3.5A	50W (T _c =25°C)	150	10	500	>10	10	1 A	10	-500	t _f < 1 μS			3*	95	10	102	水平偏向用
* # 1172B	"	"	"	1500	5	7 A	50W (T _c =25°C)	150	10	500	20	10	2 A	10	-500	t _f < 1 μS			3*	160	10	102	水平偏向用
* # 1178A	三 菱	"	Si.EP	40	4.5	5 A	35W (T _c =25°C)	175	2mA	15	30	10	200			P ₀ =26W (f=175MHz, V _{CC} =13.5V, P _i =7W)						113	
* # 1196A	東 芝	"	"	45	3.5	1 A	10W (T _c =25°C)	175	200	15	50	10	200	10	-50	P ₀ =5W (f=700MHz, V _{CC} =28V, P _i =1W)			1000*	<10		135	
* # 1197A	"	"	"	45	3.5	2 A	20W (T _c =25°C)	175	400	15	55	10	500	10	-100	P ₀ =12W (f=700MHz, V _{CC} =28V, P _i =3W)			1000*	<20		135	
* # 1206A	三 菱	"	"	45	4.5	1.7A	25W (T _c =25°C)	175	1mA	30	50	25	50			P ₀ =10.5W (f=700MHz, V _{CC} =25V, P _i =4W)						209	
* # 1206B	"	"	"	45	4.5	2 A	25W (T _c =25°C)	175	1mA	40	50	25	50			P ₀ =12W (f=700MHz, V _{CC} =25V, P _i =4W)						209	
* # 1241A	東 芝	"	"	35	3.5	2 A	20W (T _c =25°C)	175	500	15	50	5	1 A			P ₀ =11W (f=175MHz, V _{CC} =13.5V, P _i =1W)						135	
* # 1242A	"	"	"	35	3.5	4.5A	20W (T _c =25°C)	175	100	15	40	5	1.5A			P ₀ =13W (f=175MHz, V _{CC} =13.5V, P _i =1.3W)						135	
* # 1403A	サンケン	"	Si.TMe	180	6	8 A	70W (T _c =25°C)	150	1mA	180	60	4	3 A	12	-500				10*	130	7*	102	2SA745A とコンパリ
2SC515A	東 芝	PA. SW	Si.T	300	5	150	20W (T _c =25°C)	175	10	300	40~170	10	50	50	-20				100*	6		99	
* # 563A	松 下	RF	Si.EP	40	4	25	300	175	10	40	>38	10	7	10	-5				550*	C _{ob} 0.23		117C	
* # 807A	ソニー	PA	Si.TMe	580	8	10	125W (T _c =25°C)	150	5mA	500	60	3	0.1	10	-500				5.5*	285		102	
* # 780A	東 芝	SW	Si.T	150	5	30	400	125	0.1	150	70~240	3	10	10	-2	t _{on} =0.3 μS, t _f =0.4 μS t _{tr} =2 μS			100*	2		138	
* # 979A	"	RF. SW	Si.E	100	5	100	300	175	1	100	40~140	1	10	10	-10	t _{on} =25 nS, t _f =30 nS t _{tr} =400 nS			250*	3		49C	
* # 980A	"	"	"	90	5	100	400	125	0.1	50	70~140	1	10	10	-10	t _{on} =25 nS, t _f =30 nS t _{tr} =400 nS			250*	3		138	
* # 1008A	日 電	RF	"	100	8	700	800	150	0.1	60	140	2	50	10	-50				70*	15	25*	84B	2SA708A とコンパリ
* # 1033A	松 下	RF. AF	Si.TP	250	5	25	300	175	2	12	>20	10	5						60*	40		49C	
* # 1098A	日 電	PA. SW	Si.E	70	5	3 A	10W (T _c =25°C)	150	1	45	100	5	500	5	-100				60*	40		167	2SA636A とコンパリ